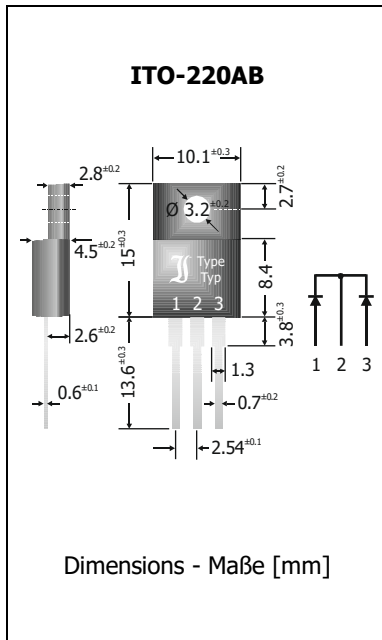


MURF2060CT Superfast Efficient Rectifier Diodes Superschnelle Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad	I_{FAV} = 2x 10 A V_{F1.25} ~ 1.25 V T_{jmax} = 175°C	V_{RRM} = 600 V I_{FSM} = 90/100 A t_{rr1} < 25 ns
---	--	---

Version 2019-12-13



Typical Applications

Rectification of higher frequencies,
High efficient switching stages
Free-wheeling diodes
Commercial grade ¹⁾

Features

Isolated package
Dual diode, common cathode
Very low reverse recovery time
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Packed in tubes	50
Weight approx.	1.8 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

Typische Anwendungen

Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Freilaufdioden
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Isoliertes Gehäuse
Doppeldiode, gemeinsame Kathode
Sehr niedrige Sperrverzugszeit
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Verpackt in Stangen	50
Gewicht ca.	1.8 g
Gehäusematerial	UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen	260°C/10s



Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]
MURF2060CT	600	600

Average forward current Dauergrenzstrom		T _C = 85°C	I _{FAV}	10 A ³⁾ 20 A ⁴⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	T _C = 85°C	I _{FRM}	18 A
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	90 A ²⁾ 100 A ²⁾
Rating for fusing – Grenzlasterintegral	t < 10 ms	T _A = 25°C	i ² t	40 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _J T _S	-50...+175°C -50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

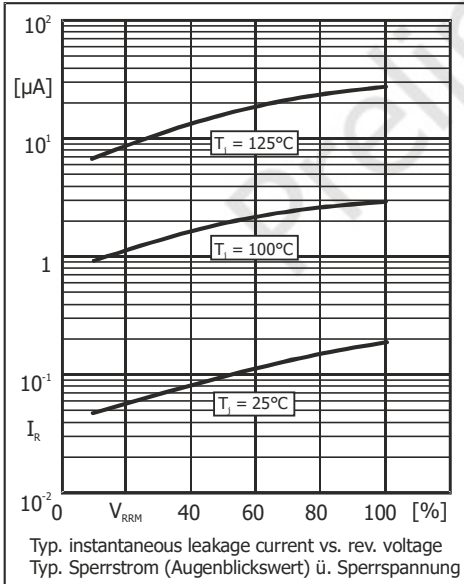
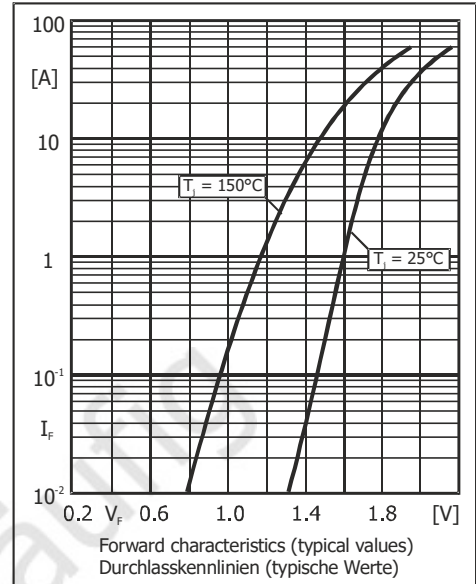
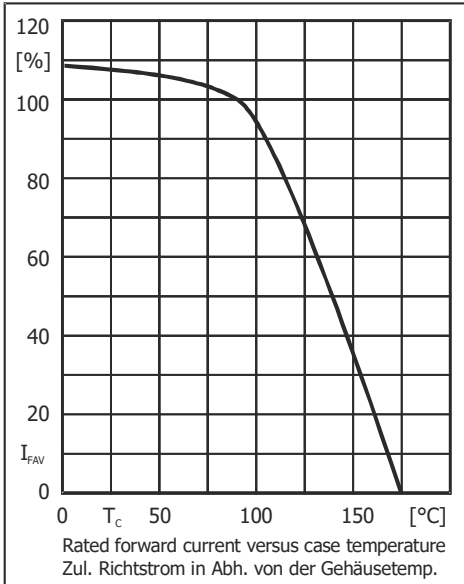
Leakage current Sperrstrom	T _J = 25°C T _J = 125°C	V _R = V _{RRM}	I _R	< 1 µA < 100 µA
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität		V _R = 4 V	C _J	typ. 40 pF
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R _{thC}	< 6.0 K/W ³⁾

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Per diode – Pro Diode
4 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)

Characteristics

Kennwerte

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	t_{rr} [ns] ¹⁾	t_{rr} [ns] ²⁾	@ T_j	V_F [V]	@ I_F [A]	@ T_j
MURF2060CT	< 25	< 50	25°C	typ. 1.25 < 2.0	10 10	150°C 25°C



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 $I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A
2 $I_F = 1.0$ A, $di/dt = -50$ A/µs, $V_R = 30$ V